Влияние кислорода на синтез и свойства легированных бором микро- и наноалмазов

 $\underline{\mathit{Kohdpuha}\ \mathit{K.M.}}^{1,2}$, Бражкин В.В. 1 , Конdpuh М.В. 1 , Екимов Е.А. 3

kondrina.km@phystech.edu

Недавнее сообщение о получении n-типа проводимости в алмазах, легированных бор-кислородными комплексами в металлическом растворителе [1], инициирует интерес к синтезу алмазов в гетероуглеводородных системах с кислородом и бором. Кислород в ростовой системе может присутствовать как неконтролируемая примесь при синтезе алмазов из боробициклононан димера $C_{16}H_{30}B_2$ (9BBN) или непосредственно входить в состав прекурсора, например, фенилборной кислоты $C_6H_5B(OH)_2$. Синтез образцов из этих двух прекурсоров осуществляли при давлениях 7-9 ГПа и температурах до 1600 С.

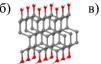
Сильнолегированные бором наноалмазы были получены только из 9BBN (концентрация $3*10^{21}$). Из фенилборной кислоты получены микрокристаллы с концентрацией бора $1-4*10^{20}$. Проводимость n-типа в алмазах, синтезированных из фенилборной кислоты и 9BBN не была обнаружена, но мы не исключаем возможность частичной компенсации примеси бора кислородом в алмазной решетке. Наше исследование показывает возможность снижения степени легирования алмаза бором в присутствии кислорода с высоким химическим сродством к бору.

С использованием метода DFT была оценена стабильность алмазных частиц легированных бором с гидрогинезироанной и окисленной поверхностями. Показано, что OH функциональные группы стабилизируют частицу с примесью бора (таблица - Рис. 1a).

С другой стороны, расчет указывает на меньшую стойкость к окислению наночастиц с бором.

Представленное исследование было профинансировано РНФ, проект № 24-12-00037.

| a) | | Pure | B-doped | Difference |
|----|---------------|---------|---------|------------|
| | H-terminated | -8.2778 | -7.0316 | 1.246 |
| | OH-terminated | -67.207 | -67.147 | 0.060 |
| | Difference | -58.929 | -60.116 | |







Результаты. a) результаты расчета энергии, б) наноалмазная пленка, использованная для расчета, в) микрокристаллы, полученные из фенилборной кислоты, г) коллоид наноалмазов, синтезированных из 9bbn.

Ссылки

1. L iu, Xiaobing, et al. "Boron-oxygen complex yields n-type surface layer in semiconducting diamond." Proceedings of the National Academy of Sciences 116.16 (2019): 7703-7711. doi 10.1073/pnas.1821612116

¹ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук, г. Троицк, 108840, г. Москва, Российская Федерация

² Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

³ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук